

SURFACE MOUNT
HIGH EFFICIENCY SILICON RECTIFIER
VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere

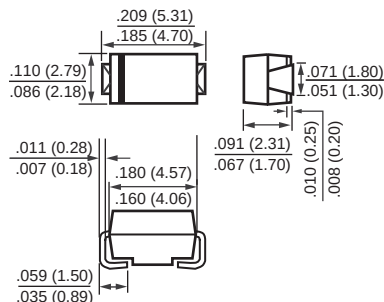
FEATURES

- * Ideal for surface mounted applications
- * Low leakage current
- * Metallurgically bonded construction
- * Mounting position: Any
- * Weight: 0.057 gram

MECHANICAL DATA

- * Epoxy : Device has UL flammability classification 94V-0

SMX



Dimensions in inches and (millimeters)

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.

MAXIMUM RATINGS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	HFM101W	HFM102W	HFM103W	HFM104W	HFM105W	HFM106W	HFM107W	HFM108W	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	50	100	200	300	400	600	800	1000	Volts
Maximum RMS Volts	V _{RMS}	35	70	140	210	280	420	560	700	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	V _{bc}	50	100	200	300	400	600	800	1000	Volts
Maximum Average Forward Current at TA = 50°C	I _o	1.0								Amps
Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	I _{FSM}	30								Amps
Typical Junction Capacitance (Note 2)	C _j	15					12			pF
Operating and Storage Temperature Range	T _J , T _{STG}	-65 to + 150								°C

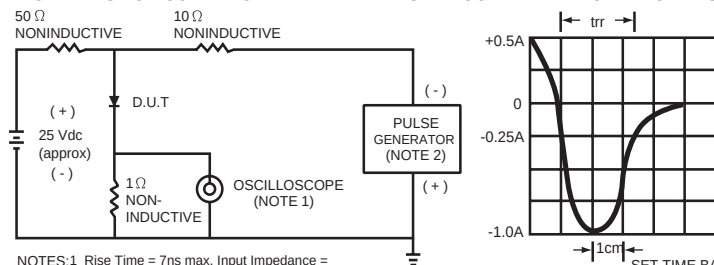
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

CHARACTERISTICS		SYMBOL	HFM101W	HFM102W	HFM103W	HFM104W	HFM105W	HFM106W	HFM107W	HFM108W	UNITS
Maximum Forward Voltage at 1.0ADC		V _F	1.0			1.3		1.7			Volts
Maximum Full Load Reverse Current, Full cycle Average T _A = 55°C		I _R	50								uAmps
Maximum DC Reverse Current at	@ T _A = 25°C		5.0								uAmps
Rated DC Blocking Voltage	@ T _A = 125°C		100								uAmps
Maximum Reverse Recovery Time (Note 1)		t _{rr}	50					75			nSec

- NOTES : 1. Test Conditions: IF=0.5A, IR=-1.0A, IRR=-0.25A.
2. Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 volts.
3. "Fully ROHS compliant", "100% Sn plating (Pb free).

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (HFM101W THRU HFM108W)

FIG. 1 - TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC



NOTES: 1. Rise Time = 7ns max. Input Impedance = 1 megohm, 22pF.
2. Rise Time = 10ns max. Source Impedance = 50 ohms.

FIG. 2 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

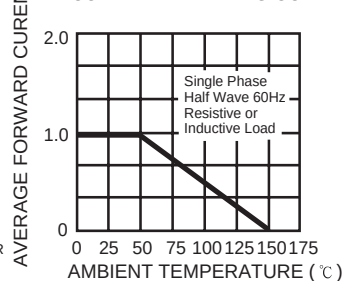


FIG. 3 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

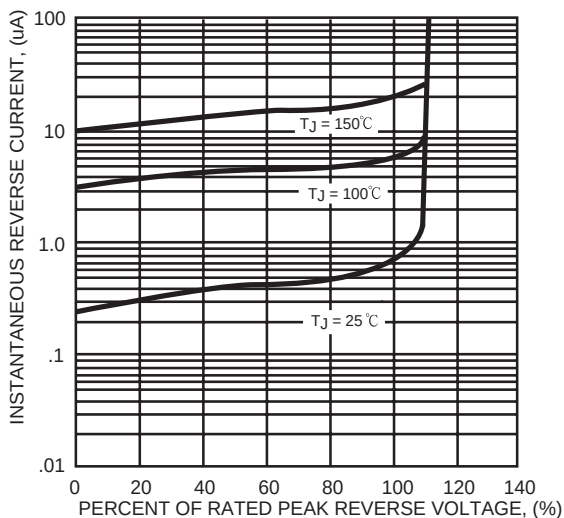


FIG. 4 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

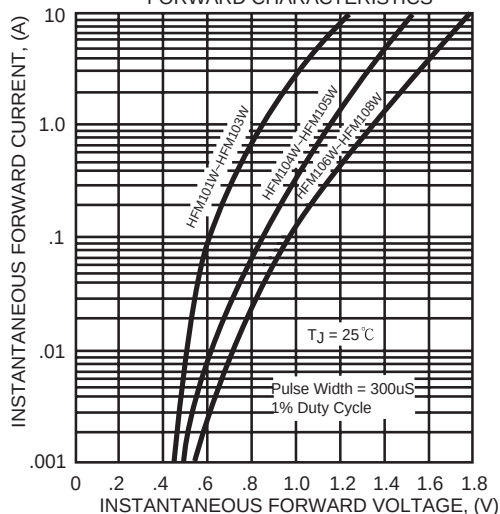


FIG. 5 - MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

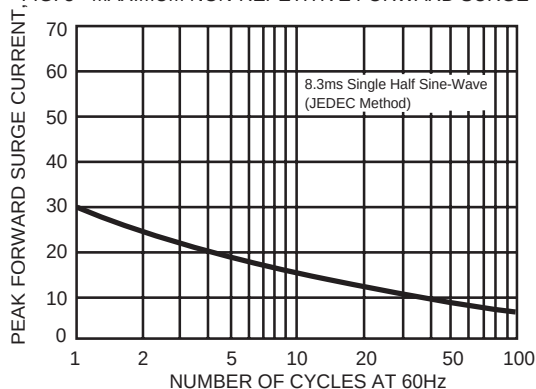
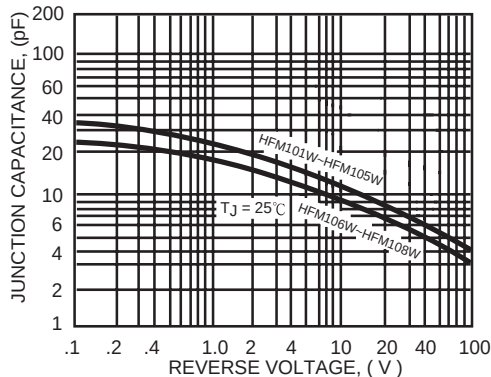
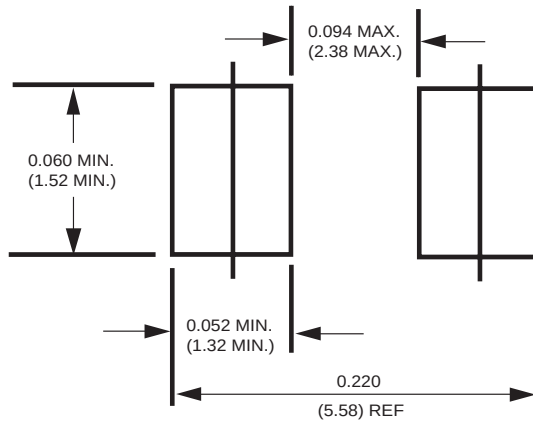


FIG. 6 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



Mounting Pad Layout



Dimensions in inches and (millimeters)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331